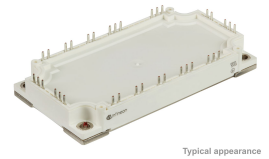


EconoPIM™3 Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC

Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften
 - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 200\text{ A} / I_{CRM} = 400\text{ A}$
 - Trenchstop™ IGBT7
 - Überlastbetrieb bis zu 175°C
 - Niedriges V_{CESat}
- Mechanische Eigenschaften
 - Integrierter NTC Temperatur Sensor
 - Lötverbindungstechnik
 - Kupferbodenplatte
 - Al_2O_3 Substrat mit kleinem thermischen Widerstand



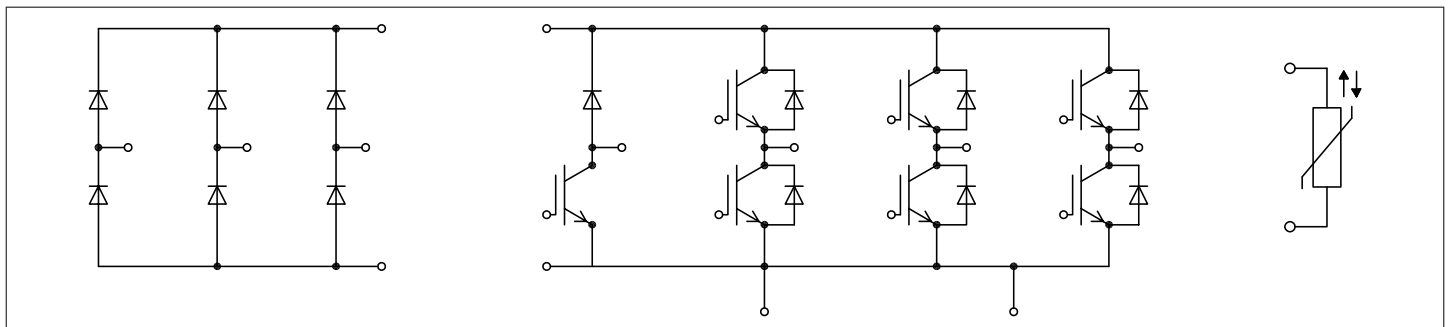
Potenzielle Anwendungen

- Hilfsumrichter
- Motorantriebe
- Servoumrichter

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	Gehäuse	3
2	IGBT, Wechselrichter	3
3	Diode, Wechselrichter	5
4	Diode, Gleichrichter	6
5	IGBT, Brems-Chopper	7
6	Diode, Brems-Chopper	8
7	NTC-Widerstand	9
8	Kennlinien	10
9	Schaltplan	16
10	Gehäuseabmessungen	17
11	Modul-Label-Code	18
	Änderungshistorie	19
	Disclaimer	20

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	2.5	kV
Material Modulgrundplatte			Cu	
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	Al_2O_3	
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kühlkörper	10.0	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kühlkörper	7.5	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	CTI		> 200	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	RTI	Gehäuse	140	°C

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Modulstreuinduktivität	L_{SCE}			25		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{AA'+CC'}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pro Schalter		1.1		mΩ
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pro Schalter		1.6		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}		-40		125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M5, Schraube	3	6	Nm
Gewicht	G			300		g

Anmerkung: Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 50A effektiv pro Anschlusspin begrenzt.

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj \max} = 175^\circ\text{C}$	$T_C = 70^\circ\text{C}$	200	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj \text{ op}}$		400	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}			±20	V

Tabelle 4 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min.	Typ.	Max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 200\ A, V_{GE} = 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.55	1.80	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		1.69		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		1.77		
Gate-Schwellenspannung	V_{GETh}	$I_C = 4.6\ mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\ ^\circ C$		5.15	5.80	6.45	V
Gateladung	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\ V, V_{CC} = 600\ V$			3.34		μC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0.75		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			40.3		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			0.14		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	$V_{CE} = 1200\ V, V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0.02	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	$V_{CE} = 0\ V, V_{GE} = 20\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$				100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	$I_C = 200\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 2.7\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.203		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.226		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.239		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_C = 200\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 2.7\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.094		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.097		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.099		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	$I_C = 200\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 2.7\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.351		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.414		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.433		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_C = 200\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 2.7\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.103		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.198		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		0.262		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_C = 200\ A, V_{CC} = 600\ V, L_\sigma = 35\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 2.7\ \Omega, di/dt = 2050\ A/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		25.1		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		38.3		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		45.9		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_C = 200\ A, V_{CC} = 600\ V, L_\sigma = 35\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 2.7\ \Omega, dv/dt = 3250\ V/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		12.9		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		20.5		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		23.8		
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\ V, V_{CC} = 800\ V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_p \leq 8\ \mu s, T_{vj} = 150\ ^\circ C$		640		A
			$t_p \leq 7\ \mu s, T_{vj} = 175\ ^\circ C$		600		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro IGBT			0.231	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro IGBT, $\lambda_{grease} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		0.0670		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\text{ op}}$		-40		175	°C

Anmerkung: $T_{vj\text{ op}} > 150^\circ\text{C}$ ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
Dauergleichstrom	I_F			200	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$		400	A
Grenzlastintegral	I^2t	$t_P = 10 \text{ ms}, V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	3700	A^2s
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$	3050	

Tabelle 6 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 200 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1.72	2.10	V
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	1.59		
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$	1.52		
Rückstromspitze	I_{RM}	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 200 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 2050 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	79.6		A
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	105		
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$	118		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 200 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 2050 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	15.7		μC
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	27.7		
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$	35.6		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 200 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 2050 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	4.85		mJ
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	9.64		
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$	12.2		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro Diode			0.376	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro Diode, $\lambda_{grease} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		0.0730		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj, op}$		-40		175	°C

Anmerkung: $T_{vj, op} > 150^\circ\text{C}$ ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

4 Diode, Gleichrichter

Tabelle 7 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1600	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip	I_{FRMSM}	$T_C = 110^\circ\text{C}$		150	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom	I_{RMSM}	$T_C = 110^\circ\text{C}$		150	A
Stoßstrom Grenzwert	I_{FSM}	$t_P = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1800	A
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	1600	
Grenzlastintegral	I^2t	$t_P = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	16200	A^2s
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	12800	

Tabelle 8 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min.	Typ.	Max.	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 200 \text{ A}$	$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		1.02		V
Sperrstrom	I_r	$T_{vj} = 150^\circ\text{C}, V_R = 1600 \text{ V}$			1.4		mA
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro Diode				0.278	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro Diode, $\lambda_{grease} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$			0.0690		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj, op}$			-40		150	°C

5 IGBT, Brems-Chopper

Tabelle 9 **Höchstzulässige Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj\text{ max}} = 175\text{ °C}$	$T_C = 75\text{ °C}$	150	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj\text{ op}}$		300	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}			±20	V

Tabelle 10 **Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min.	Typ.	Max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\text{ sat}}$	$I_C = 150\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		1.55	1.80	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		1.69		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		1.77		
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	$I_C = 3.5\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		5.15	5.80	6.45	V
Gateladung	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CC} = 600\text{ V}$			2.5		μC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$			1		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$			30.1		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$			0.105		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$			0.005	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$				100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	$I_C = 150\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 5.6\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.197		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		0.208		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		0.215		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_C = 150\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 5.6\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.085		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		0.090		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		0.093		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	$I_C = 150\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 5.6\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.419		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		0.502		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		0.521		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_C = 150\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 5.6\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.113		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		0.208		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		0.272		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 10 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_C = 150 \text{ A}$, $V_{CC} = 600 \text{ V}$, $L_\sigma = 35 \text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 5.6 \Omega$, $di/dt = 1150 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	12.2		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	19.1		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	23.1		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_C = 150 \text{ A}$, $V_{CC} = 600 \text{ V}$, $L_\sigma = 35 \text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 5.6 \Omega$, $dv/dt = 3100 \text{ V}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	10.5		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	16.1		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	20.1		
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15 \text{ V}$, $V_{CC} = 800 \text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_p \leq 8 \mu\text{s}$, $T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	480		A
			$t_p \leq 7 \mu\text{s}$, $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	450		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro IGBT			0.290	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro IGBT, $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$		0.0700		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj op}$		-40		175	$^\circ\text{C}$

Anmerkung: $T_{vj op} > 150 \text{ }^\circ\text{C}$ ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

6 Diode, Brems-Chopper

Tabelle 11 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1200	V
Dauergleichstrom	I_F		75	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	$t_p = 1 \text{ ms}$	150	A
Grenzlastintegral	$I^2 t$	$t_p = 10 \text{ ms}$, $V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	A^2s
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	

Tabelle 12 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 75 \text{ A}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1.72	2.10	V
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	1.59		
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$	1.52		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 12 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Rückstromspitze	I_{RM}	$V_{CC} = 600\text{ V}$, $I_F = 75\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 1050\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	51.8		A
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	69.2		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	79.6		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	$V_{CC} = 600\text{ V}$, $I_F = 75\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 1050\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	6.62		μC
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	13.9		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	19		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	$V_{CC} = 600\text{ V}$, $I_F = 75\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 1050\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.62		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	3.39		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	4.65		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro Diode			0.728	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro Diode, $\lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.0870		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\text{ op}}$		-40		175	°C

Anmerkung: $T_{vj\text{ op}} > 150\text{ °C}$ ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

7 NTC-Widerstand

Tabelle 13 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Nennwiderstand	R_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$		5		kΩ
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100\text{ °C}$, $R_{100} = 493\text{ Ω}$	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3433		K

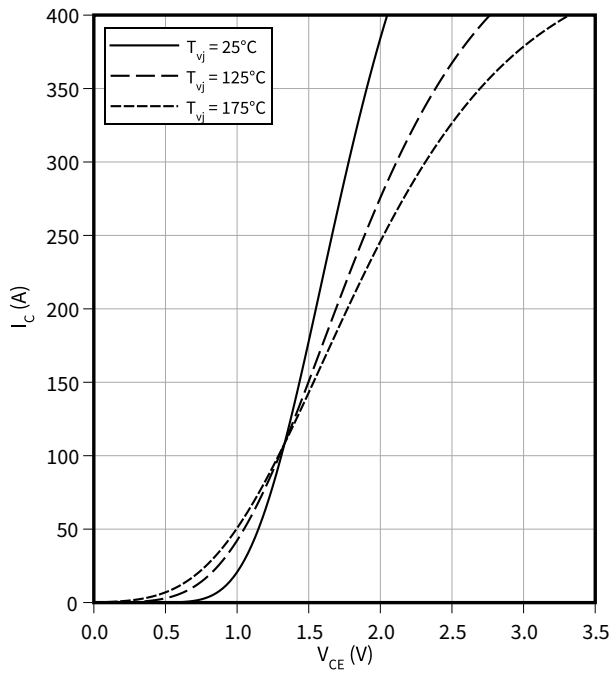
Anmerkung: Angaben gemäß gültiger Application Note.

8 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$

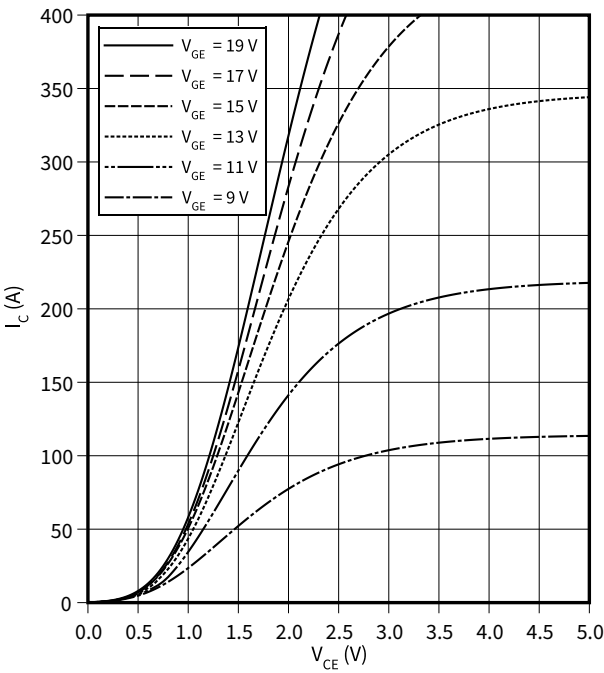
$V_{GE} = 15\text{ V}$



Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$

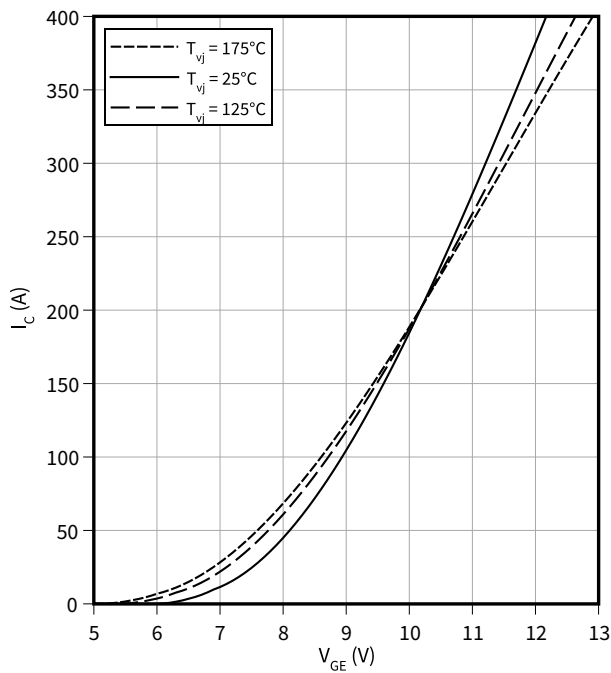
$T_{vj} = 175\text{ °C}$



Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{GE})$

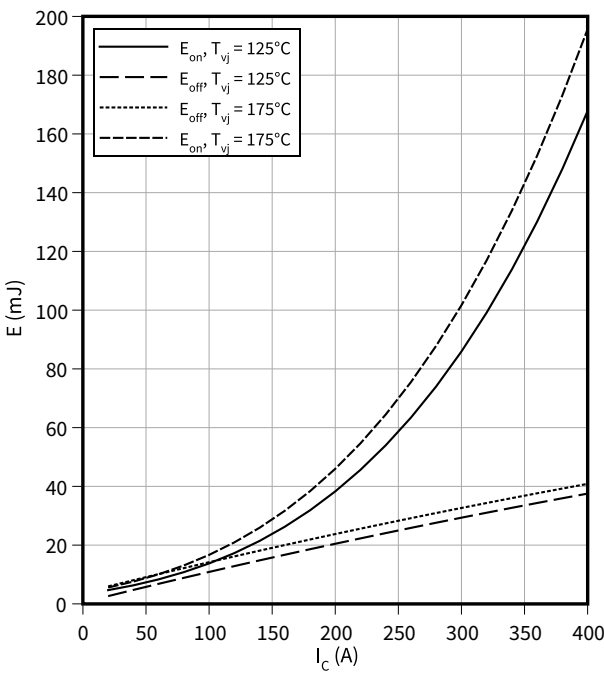
$V_{CE} = 20\text{ V}$



Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

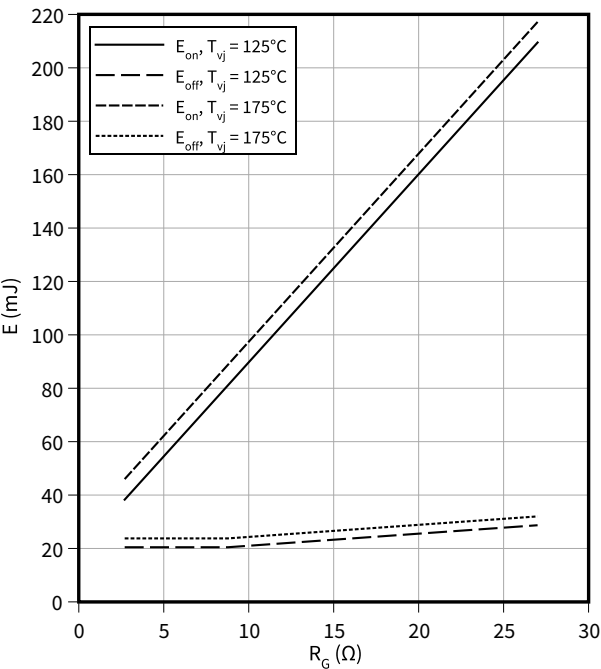
$E = f(I_C)$

$R_{Goff} = 2.7\text{ }\Omega$, $R_{Gon} = 2.7\text{ }\Omega$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$



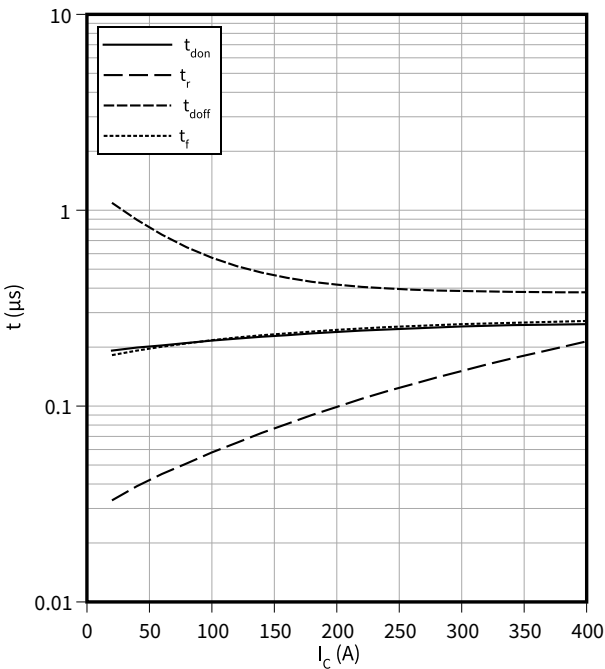
Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 200\text{ A}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$



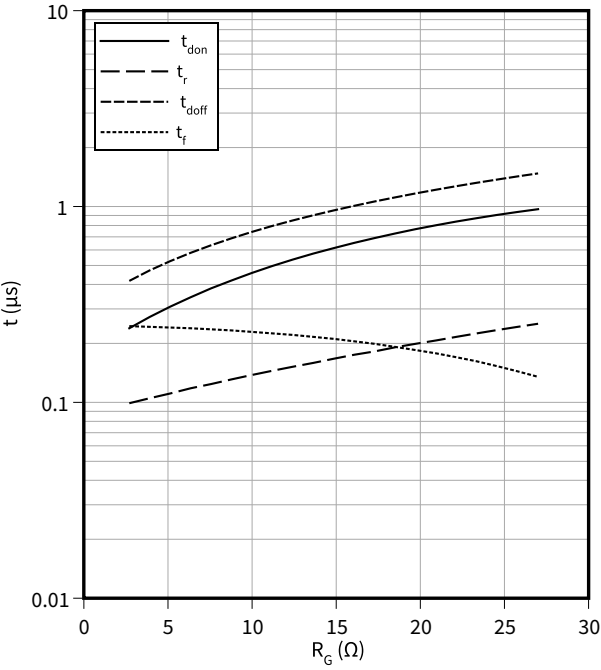
Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(I_C)$
 $R_{Goff} = 2.7\text{ } \Omega$, $R_{Gon} = 2.7\text{ } \Omega$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$, $T_{vj} = 175\text{ } ^\circ\text{C}$



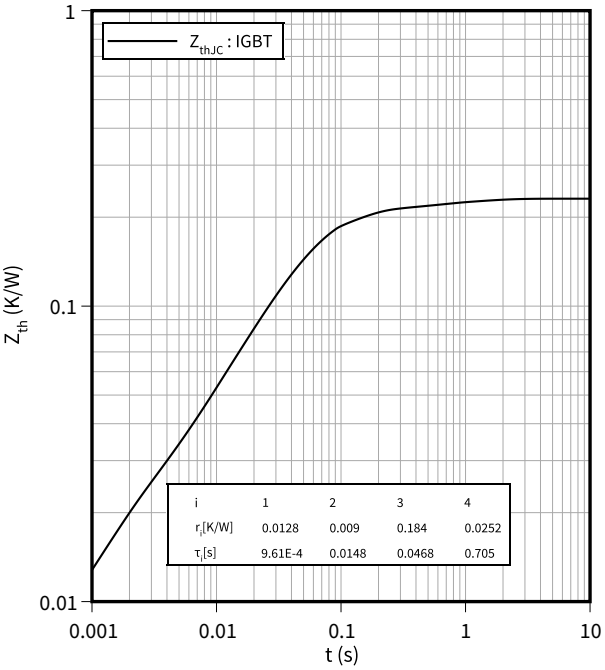
Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(R_G)$
 $I_C = 200\text{ A}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$, $T_{vj} = 175\text{ } ^\circ\text{C}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$



Transienter Wärmewiderstand , IGBT, Wechselrichter

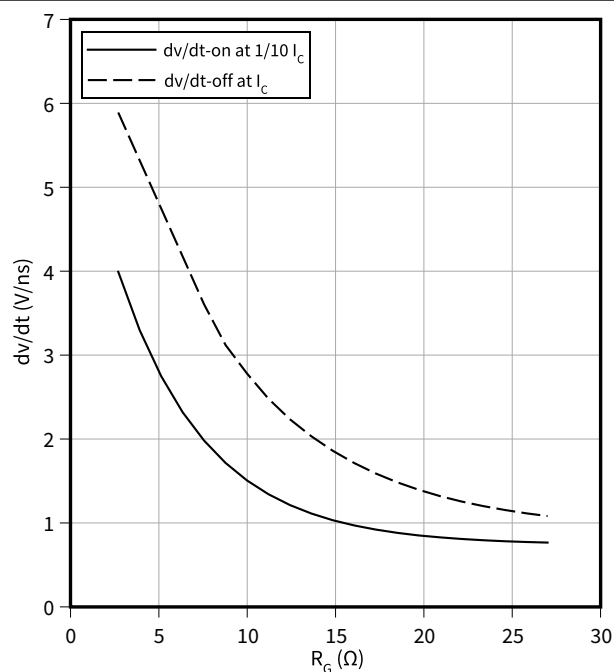
$Z_{th} = f(t)$



Spannungssteilheit (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$dv/dt = f(R_G)$$

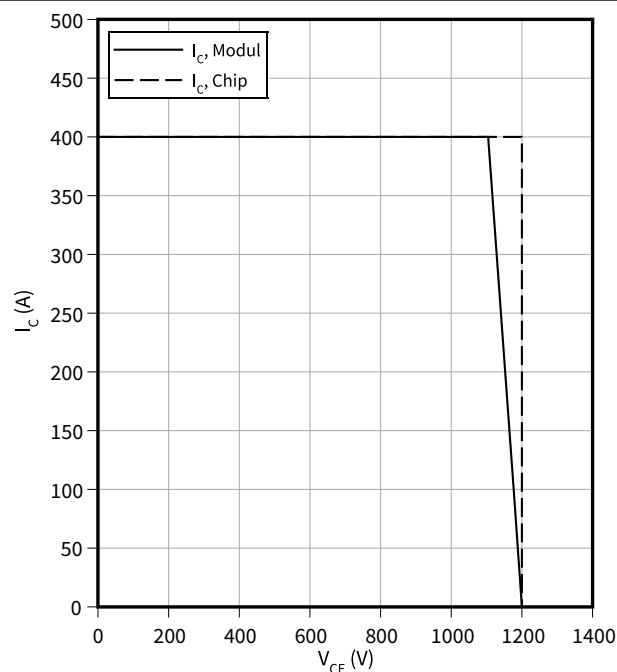
$$I_C = 200 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ °C}$$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{CE})$$

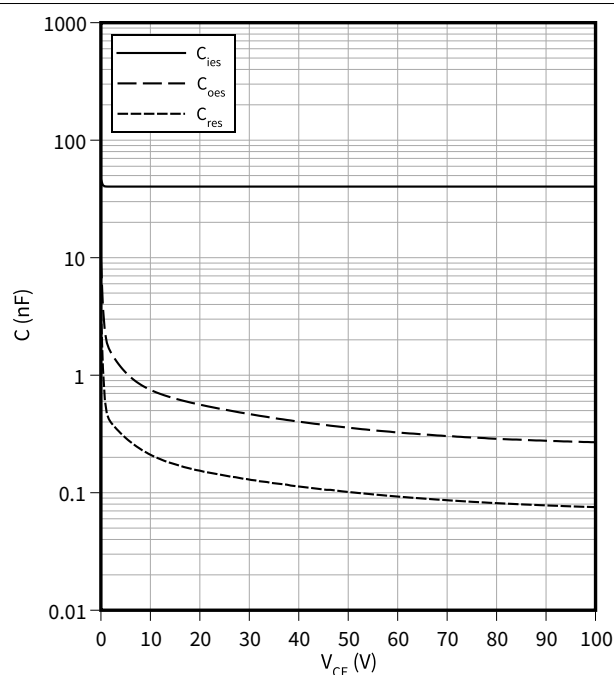
$$R_{Goff} = 2.7 \text{ Ω}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 175 \text{ °C}$$



Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$C = f(V_{CE})$$

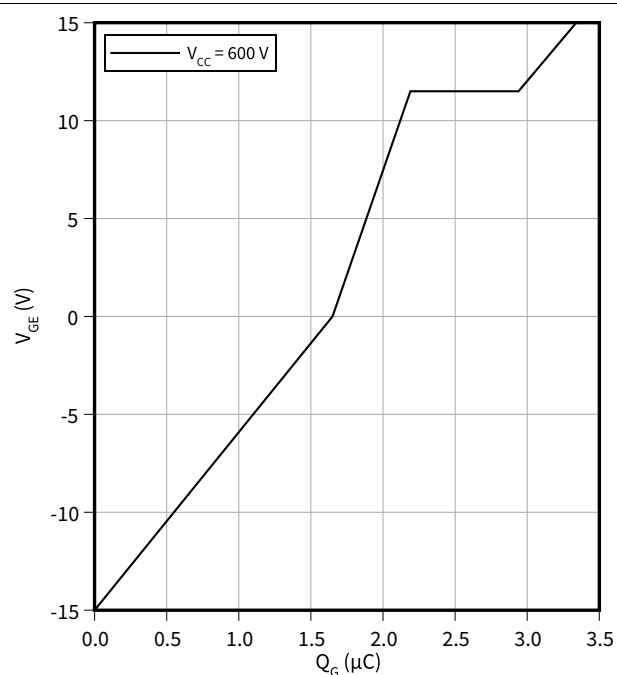
$$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ °C}$$



Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

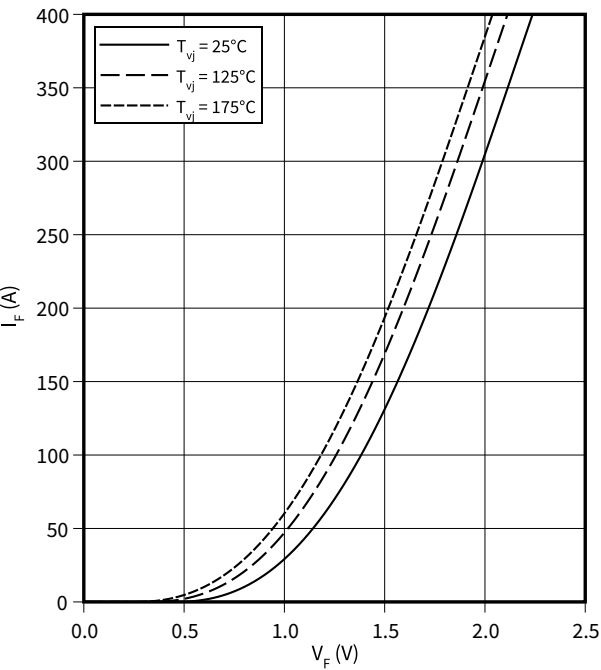
$$V_{GE} = f(Q_G)$$

$$I_C = 200 \text{ A}, T_{vj} = 25 \text{ °C}$$



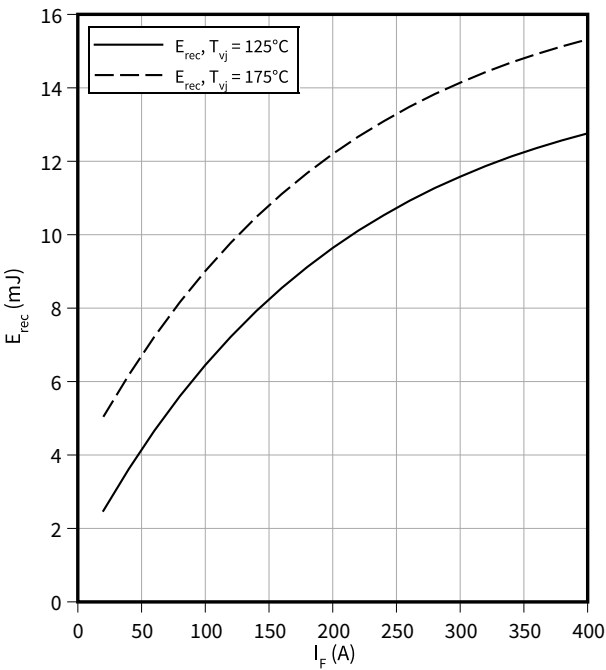
Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Wechselrichter

$I_F = f(V_F)$



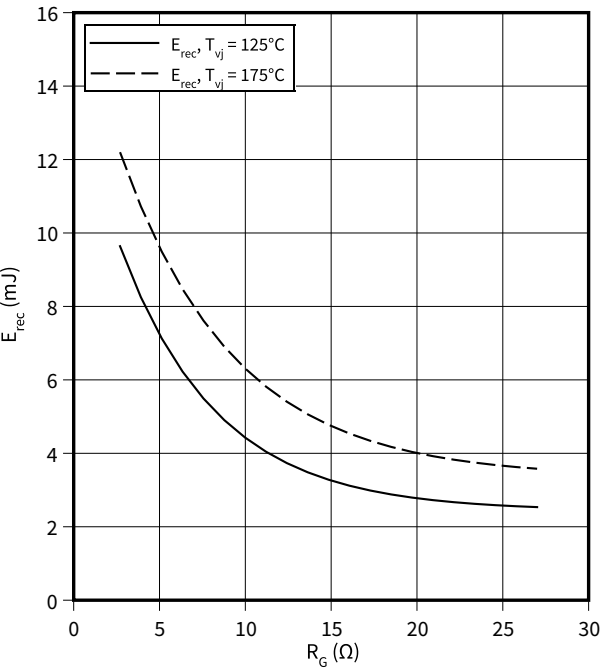
Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 2.7\ \Omega, V_{CC} = 600\ \text{V}$



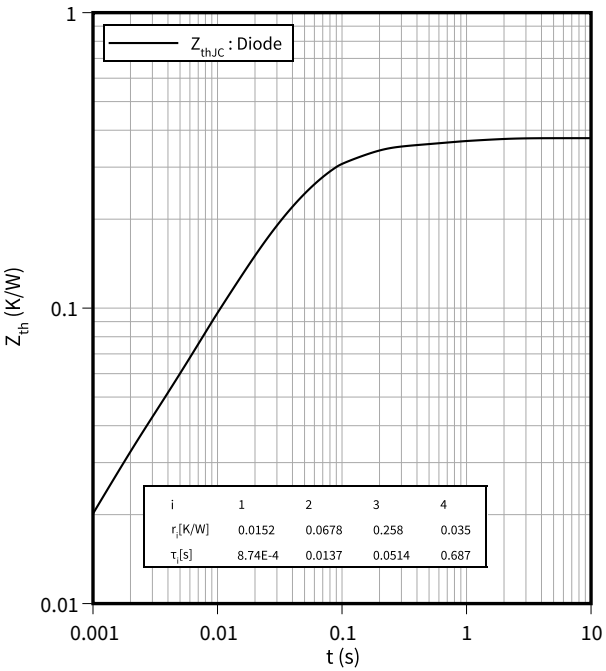
Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 200\ \text{A}, V_{CC} = 600\ \text{V}$



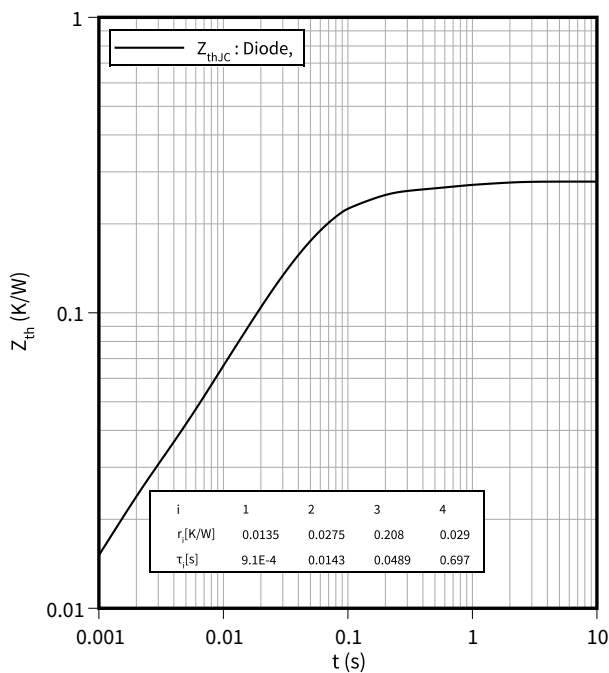
Transienter Wärmewiderstand, Diode, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$



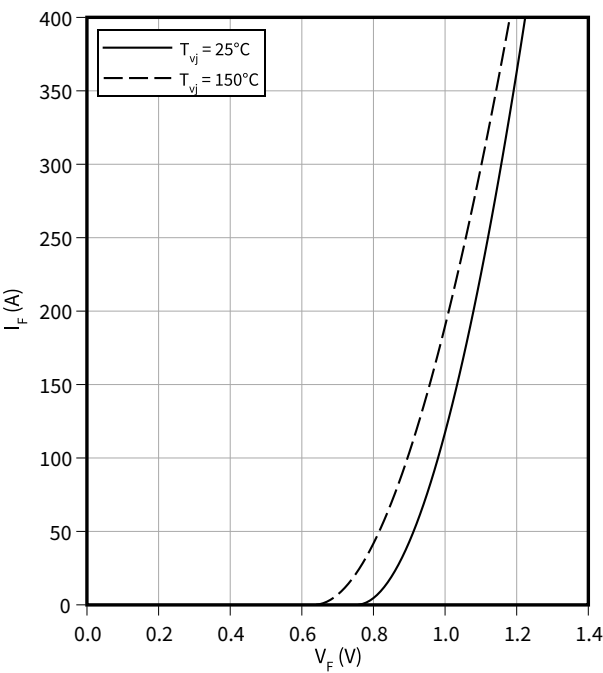
Transienter Wärmewiderstand, Diode, Gleichrichter

$Z_{th} = f(t)$



Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Gleichrichter

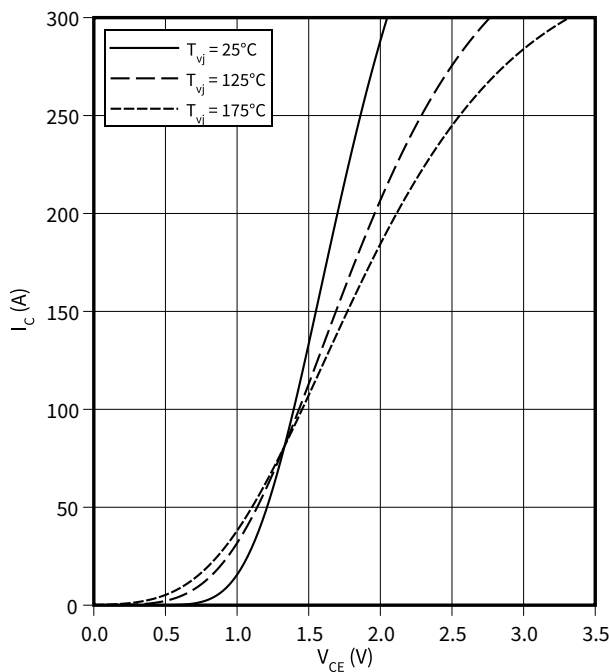
$I_F = f(V_F)$



Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Brems-Chopper

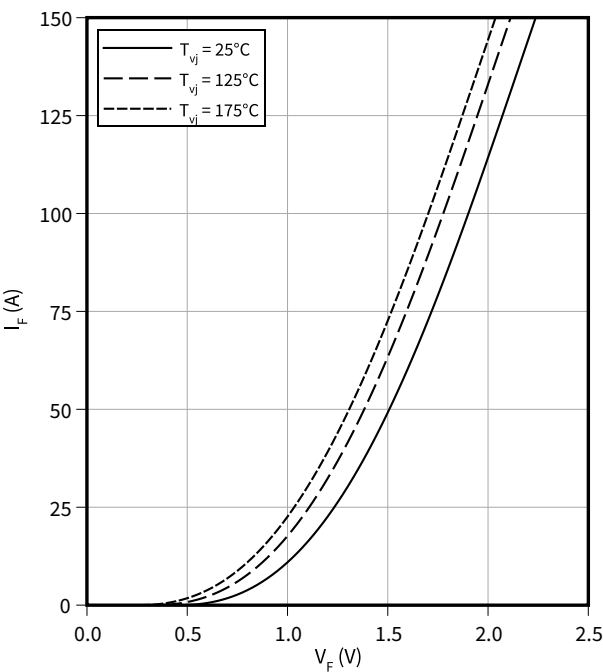
$I_C = f(V_{CE})$

$V_{GE} = 15\text{ V}$



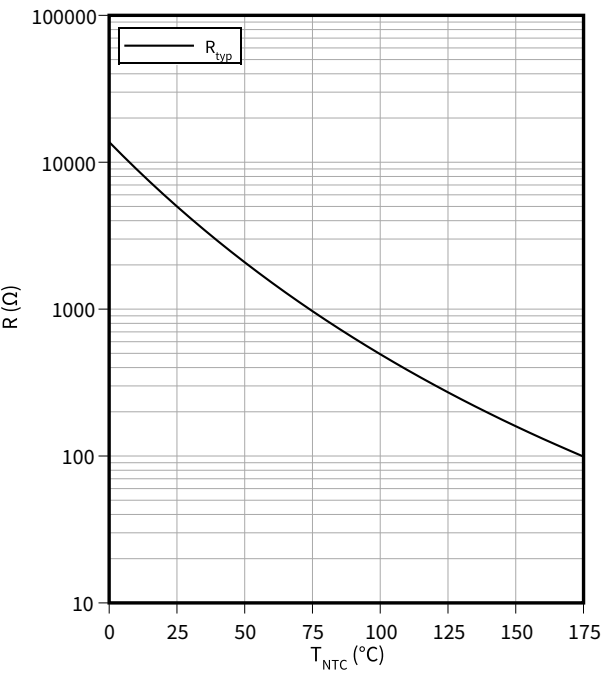
Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Brems-Chopper

$I_F = f(V_F)$



Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$



9 Schaltplan

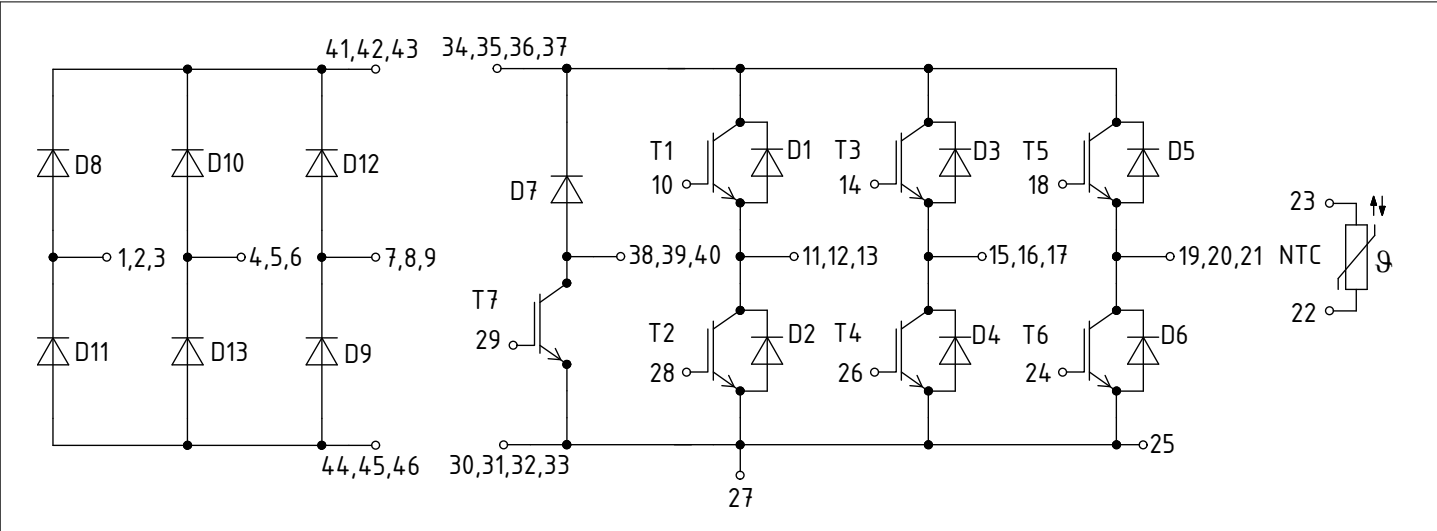
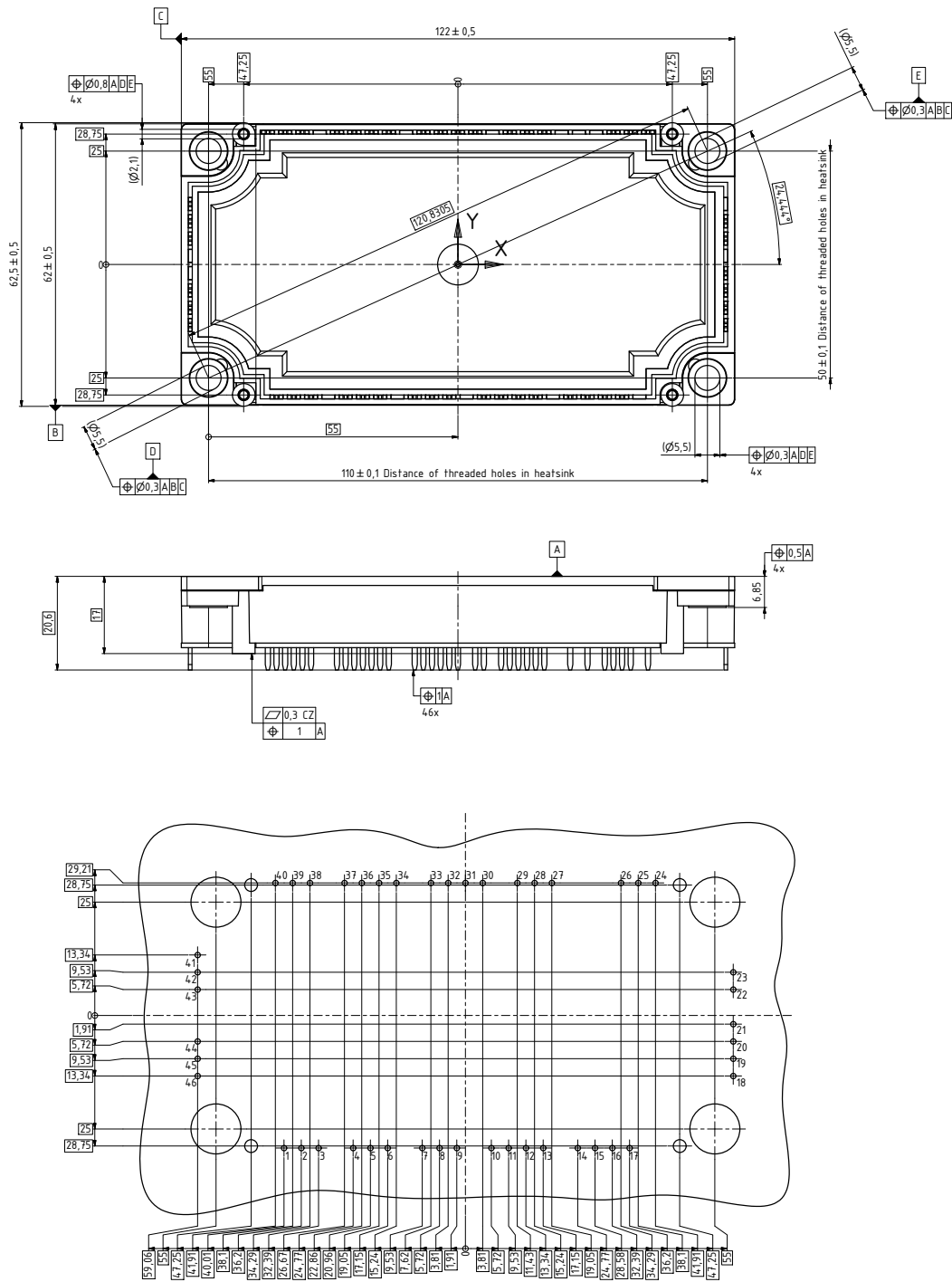


Abbildung 1

10 Gehäuseabmessungen



For PressFIT pin: Details about hole specification for contacts refer to AN2007-09
For Solderpin: Details about hole specification for contacts refer to AN2017-03

Recommended tolerance of threaded holes in heatsink $\pm 0,1$ mm.
Dimensions according to ISO 14405 (G6) (Method of least squares (LSQ)).
Reference D and E defined with (G6)
ISO 8015 - Independency principle

W0021389.00

Abbildung 2

11 Modul-Label-Code

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example	 71549142846550549911530  71549142846550549911530		

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
V1.0	2019-11-12	Target datasheet
n/a	2020-09-01	Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet = 1.xy
0.10	2021-04-13	Preliminary datasheet
1.00	2022-07-13	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2022-07-13

Published by

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2022 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-AAY213-003

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht gemäß den AEC Q100 oder AEC Q101 Dokumenten des Automotive Electronics Council qualifiziert ist.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.